
	<h2>SIR606DP-T1-GE3</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SIR606DP-T1-GE3</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 100V 37A POWERPAKSO</p> <p>Datenblätter:  SIR606DP-T1-GE3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 362 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SIR606DP-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V 37A POWERPAKSO
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	362 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	3.6V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	16.2 mOhm @ 15A, 10V
Verlustleistung (max)	44.5W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Andere Namen	SIR606DP-T1-GE3TR
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1360pF @ 50V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	22nC @ 6V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	6V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 100V 37A (Tc) 44.5W (Tc) Surface Mount
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	37A (Tc)

SIR606DP-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SIR606DP-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SIR606DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SIR606DP-T1-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SIR496DP-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 20V 35A PPAK SO-8</p>	 <p>SIR618DP-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 200V 14.2A SO8</p>	 <p>SIR610DP-T1-RE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 200V 35.4A SO-8</p>	 <p>SIR616DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 200V 20.2A SO-8</p>
 <p>SIR496DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 20V 35A PPAK SO-8</p>	 <p>SIR606DP-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 100V 37A SO8</p>	 <p>SIR496DP-T1-E3 VISHAY SIR496DP-T1-E3 VISHAY</p>	 <p>SIR606BDP-T1-RE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CHAN 100V POWERPAK SO-8</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SIR606DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay	SIR606DP-T1-GE3 Datenblatt	SIR606DP-T1-GE3-Datenblätter	SIR606DP-T1-GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SIR606DP-T1-GE3
SIR606DP-T1-GE3 Electronic	SIR606DP-T1-GE3-Komponenten	SIR606DP-T1-GE3-Verteiler	SIR606DP-T1-GE3-Bild	SIR606DP-T1-GE3-Teil
SIR606DP-T1-GE3 Preis	SIR606DP-T1-GE3 Hersteller	SIR606DP-T1-GE3 Bild	SIR606DP-T1-GE3 Aktie	SIR606DP-T1-GE3 Inventar
SIR606DP-T1-GE3 Neu	SIR606DP-T1-GE3 Original	SIR606DP-T1-GE3 garantiert	SIR606DP-T1-GE3 RFQ	SIR606DP-T1-GE3 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited